

13001S

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

■用 途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

■ 芯片示意图



■ 芯片结构

| | |
|-------|--|
| 芯片尺寸 | 630 μ m \times 630 μ m |
| 压焊区尺寸 | 基 区 110 μ m \times 110 μ m 发射区 110 μ m \times 110 μ m |
| 芯片厚度 | 220 \pm 10 μ m |
| 锯片槽宽度 | 50 μ m |
| 金属层 | 正面: Al 2.3 \pm 0.2 μ m 背面: Au 1.2 \pm 0.2 μ m |

■ 电特性(T_a=25 $^{\circ}$ C)

| 项 目 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 单 位 |
|-------------|----------------------|--|-----|-----|-----|---------|
| 集电极-基极反向电流 | I _{CBO} | V _{CB} =600V | | 5 | | μ A |
| 发射极-基极反向电流 | I _{EBO} | V _{EB} =7V | | 5 | | μ A |
| 集电极-基极击穿电压 | BV _{CBO} | I _C =0.1mA | 600 | | | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | BV _{CEO} | I _C =1mA | 400 | | 450 | V |
| 发射极-基极击穿电压 | BV _{EBO} | I _E =0.1mA | 9 | | | V |
| 直流电流增益 | h _{FE} | I _C =20mA, V _{CE} =10V | 10 | 40 | | |
| 集电极-发射极饱和电压 | V _{CE(sat)} | I _C =50mA, I _B =10mA | | 0.6 | | V |
| 贮存时间 | t _s | I _C =50mA | | 3.0 | | μ S |